

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 津田邦男 副委員長 須原理彦
幹事 東脇正高・大石敏之 幹事補佐 岩田達哉・小谷淳二

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 廣瀬文彦 副委員長 武山真弓
幹事 中村雄一・赤毛勇一 幹事補佐 木村康男・中澤日出樹・寺迫智昭

★レーザ・量子エレクトロニクス研究会 (LQE)

専門委員長 浜本貴一 副委員長 有賀 博
幹事 八木英樹・川北泰雅 幹事補佐 永井正也

◎本研究会は参加費が必要になります。

エレソの技報電子化研究会に関する御案内ページ

<https://www.ieice.org/es/jpn/e-gihou-2018es/e-gihou-2018es.htm>

日時 11月29日(木) 13:00~16:55

30日(金) 9:00~15:20

会場 名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生センター 56号館 (名古屋市昭和区御器所町. <http://www.nitech.ac.jp/access/index.html#a2> TEL (052) 735-5591 久保俊晴)

議題 窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般

29日

1. GaN/AlN 極薄膜量子井戸の作製と偏光特性 ○船戸 充・市川修平・川上養一 (京大)
2. c 面 GaN 上へのエピタキシャル AlInN 膜の成長並びにその混晶組成と微細構造の関係
○山中瑞樹・三好実人・江川孝志 (名工大)・竹内哲也 (名城大)
3. AlGaIn 深紫外 LD の実現に向けた最近の進展
○前田哲利 (理研)・山田陽一 (山口大)・定 昌史・平山秀樹 (理研)
4. GaN-MOSFET における GaN 表面処理とゲート絶縁膜アニールによるチャネル移動度の改善
○梶原瑛祐・新留 彩・彦坂年輝 (東芝)・吉岡 啓 (東芝デバイス&ストレージ)・蔵口雅彦・布上真也 (東芝)
5. n-GaN ショットキー接触の電圧印加界面顕微光応答測定 ○塩島謙次・前田昌嵩 (福井大)・三島友義 (法政大)
6. ナノインプリントによるモスアイ構造作成法に関する評価実験
○平賀健太・久保田 繁・鹿又健作・有馬ボシールアハンマド・廣瀬文彦 (山形大)
7. ALD 法を用いたフレキシブルフィルム上へのゼオライト薄膜の試作とイオン吸着特性評価
○森 義晴・野口雄祐・鹿又健作・三浦正範・有馬 ボシール アハンマド・久保田 繁・廣瀬文彦 (山形大)
8. フォト電極修飾による CdS 量子ドット太陽電池の効率向上に関する研究
○木幡優弥・三浦正範・鹿又健作・久保田 繁・廣瀬文彦・有馬 ボシール アハンマド (山形大)
9. 酒石酸添加三段パルス電気化学堆積による FeS₂O₃ 薄膜の作製と ZnO/FeS₂O₃ ヘテロ接合の作製
○季 ぶん・市村正也 (名工大)

30日午前

1. 歪み制御 AlGaInN バリア層を備えた耐圧 2.5 kV 級 AlGaInN チャネル HFET
○細見大樹・古岡啓太・陳珩・齊藤早紀・久保俊晴・江川孝志・三好実人 (名工大)
2. ALD-Al₂O₃/AlGaIn/GaN MIS-HEMT の電気特性に及ぼすアニール雰囲気の効果
○古岡啓太・久保俊晴・三好実人・江川孝志 (名工大)
3. 化学溶液析出法による無添加及び Li 添加 CuO 薄膜の成長と構造及び電気的特性
岡田英之・○寺迫智昭・五丁健治・林本直也 (愛媛大)
4. 化学溶液析出法による GZO バッファ層上への ZnO ナノロッドの成長と PEDOT:PSS/ZnO ナノロッドヘテロ接合の形成 小原翔平・○寺迫智昭・難波 優・橋国直人 (愛媛大)・矢木正和 (香川高専)・野本淳一・山本哲也 (高知工科大)
5. 電気化学堆積法による p-NiO/n-ZnO 透明太陽電池の作製 ○古山実季・市村正也 (名工大)
6. 光化学堆積法による p 型 Cu-AlO_x 薄膜の作製・評価 ○梅村将成・市村正也 (名工大)

30日午後 LQE2 (12:40~)

7. SiO₂埋め込みによる光導波構造を有する III 族窒化物面発光レーザ ○飯田涼介 (名城大)・林 葉摘・村永 亘・岩山 章・竹内哲也・上山 智・岩谷素顕 (名城大)・赤崎 勇 (名城大/名大)
8. InGaIn 量子井戸の組成揺らぎについての実験的・理論的検討

- 藤田貴志・坂井繁太・池田優真・山口敦史（金沢工大）・蟹谷裕也・富谷茂隆（ソニー）
9. 光励起誘導放出光測定による InGaN 量子井戸レーザのポテンシャル揺らぎ評価
○大島一輝・池田優真・坂井繁太・山口淳史（金沢工大）・蟹谷裕也・富谷茂隆（ソニー）
10. r 面サファイア上 a 面 AlN スパッタ膜の高品質化と特性評価
○福田 涼・正直花奈子・蔣 楠・上杉謙次郎・林 侑介・肖 世玉・三宅秀人（三重大）
11. Recent Progress towards realizing GaN/AlGaIn Quantum Cascade Lasers
○Ke Wang・Li Wang・Lin Tsung Tse・Hideki Hirayama（RIKEN）
12. GaN 系フォトニック結晶レーザ実現のための MOVPE 空孔形成方法の検討 ○小泉朋朗・江本 溪（スタンレー電気）・石崎賢司・デゾイサ メーナカ・田中良典（京大）・園田純一（スタンレー電気）・野田 進（京大）

☆ED 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月17日（月），18日（火） 東北大通研〔締切済〕 テーマ：ミリ波・テラヘルツ波デバイス・システム

2019年1月17日（木），18日（金） 日立中研〔11月10日（土）〕 テーマ：化合物半導体 IC 及び超高速・超高周波デバイス／マイクロ波／一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<https://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

東脇正高（NICT）

TEL [042] 327-6092, FAX [042] 327-5527

E-mail : mhigashi@nict.go.jp

大石敏之（佐賀大）

TEL [0952] 28-8642

E-mail : oishi104@cc.saga-u.ac.jp

☆CPM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月5日（水）～7日（金） サテライトキャンパスひろしま〔締切済〕 テーマ：デザインガイア 2018—VLSI 設計の新しい大地—

☆LQE 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月6日（木），7日（金） 慶大〔締切済〕 テーマ：半導体レーザ関連技術，パッシブデバイス技術，シリコンフォトニクス

【問合先】

八木英樹（住友電工）

TEL [045] 851-2174

E-mail : yagi-hideki@sei.co.jp

川北泰雅（古河電工）

TEL [045] 311-1219

E-mail : yasumasa.kawakita@furukawaelectric.com

◎LQE 研究会ホームページ

<http://www.ieice.org/~lqe/jpn/welcome.html>

◎LQE 研究会では LQE 奨励賞を設けております。対象は発表年度の4月1日時点で32歳以下の若手研究者（学生を含む）です。積極的に御投稿下さい。